

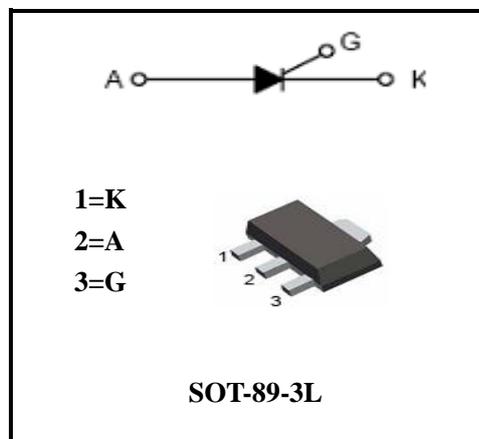
2P4M(SOT-89-3L)单向可控硅

I 特点:

- I 先进的平面钝化技术, 进一步提高了电压稳固性和可靠性, 单面台面结构, 半循环交流和脉冲直流导通, 门极灵敏触发, 触发电流一致性佳, 耐电流冲击能力强, 出色的可靠性和产品质量。

I 用途:

- I 广泛应用于高压点火电路 - 例如摩托车、燃气用具、电围栏; 稳压器 - 例如摩托车; 安全停机和保护电路 - 例如电子镇流器; 断路器、GFCI、ELCB、RCD 等; 浪涌保护电路 - 例如离线式电源; 小型通用电机转速控制 - 例如电动工具、厨房电器。



I 极限参数:

名称	符号	规范值	单位	测试条件
重复峰值阻断电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
反向重复峰值电压	V_{DRM}	>600	V	$I_{RRM}=50\mu A$
通态电流	$I_{T(RMS)}$	2.0	A	正弦波, 180 度
浪涌电流	I_{TSM}	20	A	正弦波, 50HZ
结温	T_j	125	$^{\circ}C$	----
储存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}C$	----

I 电特性 ($T_c=25^{\circ}C$):

名称	符号	测试条件	Min	Max	单位
重复峰值阻断泄漏电流	I_{DRM}	$V_D=V_{DRM}$	----	100	μA
通态电压	V_{TM}	$I_T=0.6A$	----	1.7	V
门极触发电流	I_{GT}	$V_D=7V, I_T=0.1A$	----	120	μA
门极触发电压	V_{GT}	$V_D=7V, I_T=0.1A$	----	0.9	V
门极不触发电压	V_{GD}	$V_D=V_{DRM}$	0.2	----	V
断态电压临界上升率	dv_D/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=110^{\circ}C$	10	----	V/ μs
维持电流	I_H	$V_D=12V T_j=25^{\circ}C$	----	10	mA